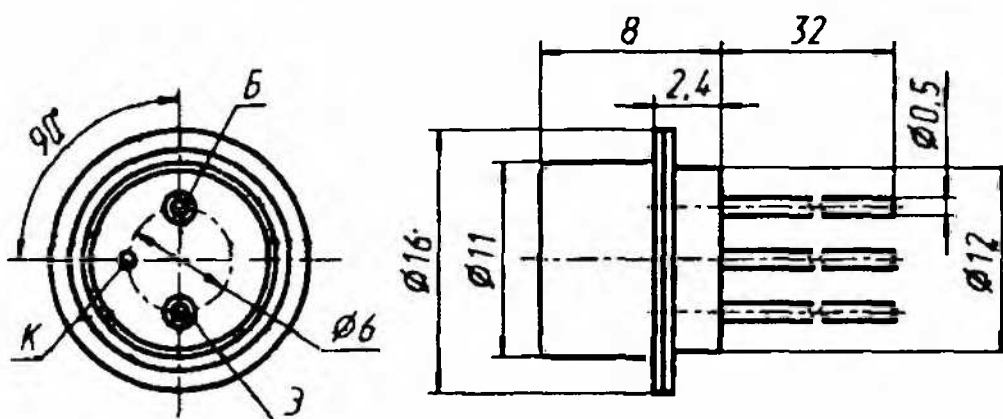


КТ604А, КТ604Б, КТ604АМ, КТ604БМ

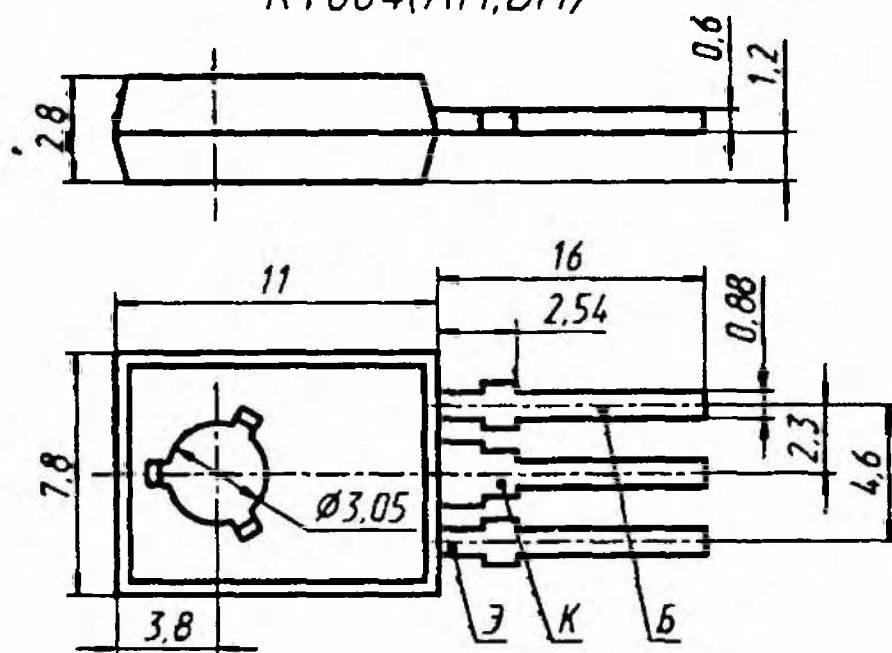
Транзисторы кремниевые мезопланарные структуры *n-p-n*. Предназначены для применения в операционных усилителях, видеоусилителях и генераторах разверток. Транзисторы КТ604А, КТ604Б выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами, КТ604АМ, КТ604БМ — в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзисторов в металлостеклянном корпусе не более 5 г, в пластмассовом — не более 1 г.

КТ604(А,Б)



КТ604(АМ,БМ)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $U_{кб} = 40$ В, $I_3 = 20$ мА:

КТ604А, КТ604АМ	10...40
КТ604Б, КТ604БМ	30...120

Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 40$ В, $I_3 = 20$ мА,
не менее

40 МГц

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер
при $I_k = 20$ мА, $I_б = 2$ мА, не более

8 В

Емкость коллекторного перехода
при $U_{кб} = 40$ В, $f = 2$ МГц, не более

7 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{зб} = 0$,
 $f = 2$ МГц, не более

50 пФ

Обратный ток коллектор—эмиттер
при $U_{кз} = 250$ В, не более

20 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{зб} = 5$ В,
не более

50 мкА

Пределы эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

при $T \leq +100$ °С

300 В

при $T = +150$ °С

150 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер
при $R_{бз} = 1$ кОм:

при $T \leq +100$ °С

250 В

при $T = +150$ °С

125 В

Постоянное напряжение эмиттер—база:

при $T \leq +100$ °С

5 В

при $T = +150$ °С

2,5 В

Постоянный ток коллектора

200 мА

Постоянная рассеиваемая мощность:

без теплоотвода:

$T \leq +25$ °С

0,8 Вт

$T = +100$ °С

0,33 Вт

с теплоотводом:

$T_k \leq +25$ °С

3 Вт

$T_k = +100$ °С

1,25 Вт

Тепловое сопротивление:

переход—корпус

40 °С/Вт

переход—окружающая среда

150 °С/Вт

Температура *p-n* перехода +150 °С
Температура окружающей среды и корпуса -60...+100 °С

Изгиб выводов транзисторов в металлостеклянном корпусе допускается не ближе 5 мм от корпуса с радиусом закругления не менее 3 мм. При этом должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие неподвижность вывода между местом изгиба и стеклянным изолятором.

Изгиб выводов транзисторов в пластмассовом корпусе допускается под углом не более 90° в плоскости, перпендикулярной плоскости основания корпуса транзистора, и не ближе 3 мм от корпуса транзистора с радиусом изгиба не менее 1,5 мм.

При монтаже допускается пайка выводов не ближе 5 мм от корпуса. Пайку следует производить в течение не более 10 с, температура паяльника не должна превышать +260 °С. Необходимо осуществлять теплоотвод между корпусом и местом пайки.